

	TPS1100DR	
	Hersteller-Teilenummer:	TPS1100DR
Hersteller / Marke:	N/A	
Teil der Beschreibung:	MOSFET P-CH 15V 1.6A 8-SOIC	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 49197 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Artikelnummer	TPS1100DR
Hersteller	N/A
Beschreibung	MOSFET P-CH 15V 1.6A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	49197 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	180 mOhm @ 1.5A, 10V
Verlustleistung (max)	791mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.45nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	15V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.6A (Ta)

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>TPS1001 MOT TPS1001 MOT</p>	 <p>TPS1100DRG4 T TPS1100DRG4 T</p>	 <p>TPS1002 MOT TPS1002 MOT</p>	 <p>TPS106041DDAR TI TI SOP8</p>
 <p>TPS1100PW N/A MOSFET P-CH 15V 1.27A 8-TSSOP</p>	 <p>TPS1100D N/A MOSFET P-CH 15V 1.6A 8-SOIC</p>	 <p>TPS1100DR MOS TI TI SOP-8</p>	 <p>TPS1100YD TI TPS1100YD TI</p>

TPS1100DR Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

TPS1100DR	TPS1100DR Datenblatt	TPS1100DR-Datenblätter	TPS1100DR PDF	TPS1100DR
TPS1100DR Electronic	TPS1100DR-Komponenten	TPS1100DR-Verteiler	TPS1100DR-Bild	TPS1100DR-Teil
TPS1100DR Preis	TPS1100DR Hersteller	TPS1100DR Bild	TPS1100DR Aktie	TPS1100DR Inventar
TPS1100DR Neu	TPS1100DR Original	TPS1100DR garantiert	TPS1100DR RFQ	TPS1100DR Online bestellen

Contact us: Info@YIC-Electronics.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited